

シリコンNPN拡散接合形トランジスタ
SILICON NPN DIFFUSED JUNCTION TRANSISTOR

2SD234, 2SD235

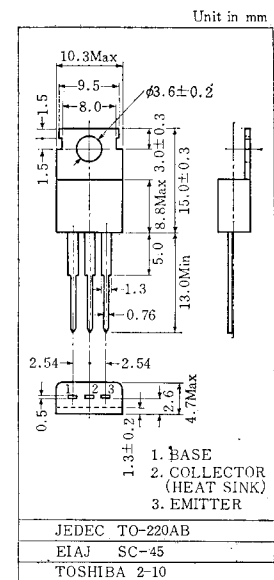
○低周波電力増幅用

○ Audio Power Amplifier Applications

- 飽和電圧が低い. : $V_{CE(sat)}=0.2V$ (Typ.)
($I_C=1A$) 2SD235
- 許容コレクタ損失が大きい : $P_C=25W$ ($T_C=25^\circ C$)
- 2SB434, 2SB435 とコンプリメンタリになります.
- Complementary to 2SB434 and 2SB435.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	60	V
2SD235		50	
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	50	V
2SD235		40	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	10	V
コレクタ電流	I_C	3	A
エミッタ電流	I_E	-3	A
コレクタ損失	P_C	1.5	W
$T_a=25^\circ C$ $T_C=25^\circ C$		25	
接合温度	T_J	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$



アクセサリはAC75を適用
MOUNTING KIT NO. AC75

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=20V, I_E=0$	—	—	100	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V, I_C=0$	—	—	100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=100mA, I_E=0$	50	—	—	V
2SD235			40	—	—	
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10mA, I_C=0$	10	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (Note)	$V_{CE}=5V, I_C=0.5A$	40	80	240	
		$V_{CE}=5V, I_C=2.5A$	15	25	—	
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=3A, I_B=0.3A$	—	0.5	1.2	V
		$I_C=1A, I_B=0.05A$	—	0.2	1.0	
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=5V, I_C=0.5A$	—	0.68	0.9	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=5V, I_E=-0.5A$	—	1	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$	—	250	—	pF

Note ; $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し, 現品表示してあります.

According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SD234 and 2SD235 are classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SD234—R 2SD235—R	40	80
2SD234—O 2SD235—O	70	140
2SD234—Y 2SD235—Y	120	240